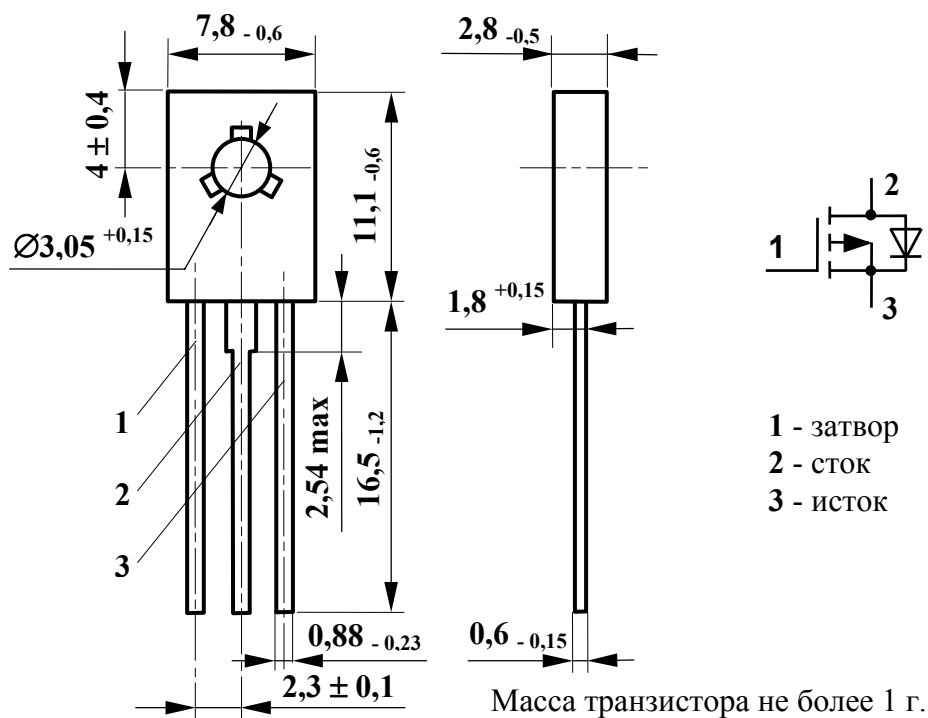


АДБК.432140.102ТУ

Полевые транзисторы с изолированным затвором и Р каналом в пластмассовом корпусе КТ 27-2 предназначены для эксплуатации в следующих режимах работы:

аналоговом (работа в активной области): применяются в усилителях синусоидального и импульсного сигналов, генераторах постоянного и переменного токов, стабилизаторах напряжения и других аналоговых устройствах;

ключевом: применяются в качестве мощных переключающих быстродействующих элементов импульсных источников вторичного электропитания, регуляторах, преобразователях, схемах управления электродвигателями, реле и другой радиоэлектронной аппаратуре.



Условия эксплуатации

Механические воздействия по второй группе эксплуатации ГОСТ 11630, в том числе:

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот	1...2000 Гц
амплитуда ускорения	100 м/с ²

Линейное ускорение	1000 м/с ²
--------------------------	-----------------------

Электрические параметры (Т_{корп.}==25°C).

Пробивное напряжение, U _{зи} = 0, I _с = -250мкА, не менее	-200 В
Пороговое напряжение, U _{зи} = U _{си} , I _с = -0,25мА	(-4...-2)В
Крутизна характеристики, I _с = -0,9А, U _{си} = -25В, t _и < 300мкс, Q > 50, не менее	0.9А/В
Остаточный ток стока, U _{си} = -200В, U _{зи} = 0, не более	-100мкА
U _{си} = -160В, U _{зи} = 0, t _{корп.} = 125°C, не более	-500мкА
Ток утечки затвора, U _{зи} = +20В, не более	+100нА
U _{зи} = минус 20В, не более	Минус100нА
Ток стока, U _{зи} = -10В, U _{си} = -7В, t _и < 300мкс, Q > 50, не менее	-1.8А
Входная емкость, U _{зи} = 0 В, U _{си} = -25В, f = 1МГц, не более	180пФ
Выходная емкость, U _{зи} = 0 В, U _{си} = -25В, f = 1МГц, не более	70пФ
Пропускная емкость, U _{зи} = 0 В, U _{си} = -25В, f = 1МГц, не более	20пФ
Время задержки включения, I _с = -0.9А, U _{си} = -100В, R _с = 50 Ом, R _г = 11 Ом, тип	8нс
Время роста, I _с = -0.9А, U _{си} = -100В, R _с = 50 Ом, R _г = 11 Ом, тип ..	15нс
Время задержки выключения, I _с = -0.9А, U _{си} = -100В, R _с = 50 Ом, R _г = 11 Ом, тип	10нс
Время спада, I _с = -0.9А, U _{си} = -100В, R _с = 50 Ом, R _г = 11 Ом, тип ..	8нс
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии, U _{зи} = -10В, I _с = -0,9А, t _и < 300мкс, Q > 50, не более	3 Ом
Напряжение на диоде при прямом включении, I _с = 1.8А, U _{зи} = 0 В, t _и < 300мкс, Q > 50, не более	5,8В
Время обратного восстановления диода, I _{прям} = -1.8А, di/dt = -100 А/мкс, типовое	240нс
не более	360нс
Объемный заряд, I _{прям} = -1.8А, di/dt = -100 А/мкс, типовое	1.7мкКл
не более	2.6мкКл

Предельно допустимые режимы эксплуатации.

Максимально допустимый постоянный ток стока, t _{корп.} = 25°C, U _{зи} = -10В	-1.8А
Максимально допустимый постоянный ток стока, t _{корп.} = 100°C, U _{зи} = -10В	-1А
Максимально допустимый импульсный ток стока, t _{корп.} = 25°C	-7А
Максимально допустимая постоянная мощность рассеивания, t _{среды.} = 25°C	33Вт
Максимально допустимое напряжение затвор-исток, t _{корп.} = 25°C	±20В
Максимально допустимая температура перехода	(-55...+150) °C
Максимально допустимая температура хранения	(-55...+150) °C
Максимальное напряжение сток-исток	-200В
Максимально допустимый постоянный прямой ток диода, t _{корп.} = 25°C	1.8А
Максимально допустимый импульсный прямой ток диода, t _{корп.} = 25°C	7А
Тепловое сопротивление переход-корпус	3.75 °C/Вт
Тепловое сопротивление переход-среда	100 °C/Вт